

## ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНЕШНЕЙ ИОНОСФЕРЫ ПО ЕЁ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ

Гринченко С.В.

*Институт ионосферы НАН и МОНМС Украины, г. Харьков*

Для описания профиля электронной концентрации используется формула  $n_e(h)$ , имеющая в качестве входных данных геометрические параметры профиля, которые визуальным образом снимаются с графического изображения профиля:  $\lg n_{e\text{m}F2}$  – значение логарифма электронной концентрации в максимуме слоя F2;  $h_{\text{m}F2}$  – высота максимума слоя F2;  $t_u$  – верхняя полутолщина слоя F2, под которой понимается изменение высоты вверх от  $h_{\text{m}F2}$ , при котором концентрация электронов уменьшается в 2 раза;  $\lg n_e(h=1000 \text{ км})$  – значение логарифма электронной концентрации на высоте 1000 км;  $s$  – величина, равная перепаду высоты, при котором концентрация электронов при экспоненциальном распределении её, характерном для высоты 1000 км, уменьшается в 10 раз (величина  $s$  – это «десятичная» шкала высот  $H_{10}$ , характеризующая функцию  $n_e = n_{e0} \cdot 10^{-\frac{h}{H_{10}}}$ ):

